

출력 일자: 2003/5/31

발송번호 : 9-5-2003-019951745

수신 : 서울 중구 순화동 1-170 에이스타워 4층

발송일자 : 2003.05.30

신영무 귀하

제출기일 : 2003.07.30

100-712

특허청 의견제출통지서

출원인 명칭 주식회사 하이닉스반도체 (출원인코드: 119980045698)

주소 경기 이천시 부발읍 아미리 산136-1

대리인 성명 신영무

주소 서울 중구 순화동 1-170 에이스타워 4층

출원번호 10-2001-0038421

발명의 명칭 반도체 소자의 제조 방법

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기 제출 기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통지는 하지 않습니다.)

[이유]

이 출원의 특허청구범위 제 전항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

[아래]

본원 발명은 전체 구조 상부에 제1 캡핑층 및 제2 캡핑층을 형성하는 것을 주요특징으로 하는 반도체 소자의 제조방법에 관한 발명이나, 일본공개특허공보 평8-241932호(1996.9.17 공개)의 요약, 청구항1, 제1 실시예 및 도1-2에 게이트 전극을 형성한 후에 실리콘 산화막과 실리콘 질화막을 형성하는 공정이 기재되어 있어, 본원 발명은 일본공개특허공보 평8-241932호(1996.9.17 공개)의 공지기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있습니다

[첨부]

첨부1 일본공개특허공보 평8-241932호(1996.09.17) 1부 끝.

2003.05.30

특허청

심사4국

반도체1심사담당관실

심사관 반성원



<<안내>>

문의사항이 있으시면 ☎ 042-481-5982 로 문의하시기 바랍니다.

특허청 직원 모두는 깨끗한 특허행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행위 등이 있으면 신고하여 주시기 바랍니다.

▶ 홈페이지(www.kipo.go.kr)내 부조리신고센터

